

Semi-conducteur : Samsung passe à la gravure 14 nm next gen

Samsung Electronics vient d'annoncer qu'il avait commencé la production de masse de composants **14 nm LPP**. Des puces 14 nm basse consommation (LPP signifiant low-power plus). Un élément clé pour aborder sereinement le marché de la mobilité.

Rappelons en effet que toutes les puces 14 nm ne se valent pas. Les fondeurs peuvent opter pour une large gamme de méthodes de gravure, allant de la **haute performance CPU** (des puces capables de monter à des fréquences extrêmes, mais gourmandes en énergie) à la **haute performance énergétique** (très basse consommation, mais grimant plus rapidement avec l'accroissement de la fréquence).

15 % mieux que le 14 nm LPE

Depuis le premier trimestre 2015, Samsung utilisait le processus **14 nm LPE** (low-power early), [rappelle Digitimes](#). Le mode LPP utilise **15 %** d'énergie en moins à fréquence équivalente, tout en permettant de créer des puces pouvant être cadencées **15 %** plus rapidement. La firme gagne donc ici sur les deux tableaux, énergie et performances.

Le 14 nm LPP sera employé pour créer des puces ARM extrêmes comme l'**Exynos 8** de Samsung. Mais également le **Snapdragon 820** de Qualcomm, comme nous l'avions évoqué hier dans notre article « [Smartphones et stockage au cœur de l'activité de Samsung en 2016](#) ». Point commun entre ces deux puces, l'utilisation de cœurs ARM 64 bits conçus respectivement par Samsung et Qualcomm, et non de cœurs ARM standards.

À lire aussi :

[Samsung Electronics devrait rater de peu ses objectifs](#)

[CES 2016 : Samsung livre un SSD de poche de 2 To](#)

[Smartphones : Samsung baisse, Apple monte](#)